

<<MOS集成电路结构与制造技术>>

图书基本信息

书名：<<MOS集成电路结构与制造技术>>

13位ISBN编号：9787532399901

10位ISBN编号：7532399907

出版时间：1970-1

出版时间：上海科学技术出版社

作者：潘桂忠 等著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<MOS集成电路结构与制造技术>>

内容概要

《MOS集成电路结构与制造技术》利用集成电路剖面结构技术，系统地介绍MOS集成电路结构和典型集成电路制造技术，包括PMOS（E/E型、E/D型）、NMOS（E/E型、E/D型）、CMOS（P-Well、N-Well、TWin-Well）、LV/HV兼容CMOS、BiCMOS、LV/HV兼容BiCMOS以及LV/HV兼容BCD。

书中描绘出组成各种集成电路的各种元器件工艺剖面结构，从而建立了元器件工艺剖面结构中高达120余种的基本单元库。

根据基本单元库描绘出高达360余种电路芯片工艺剖面结构。

然后根据电路芯片工艺剖面结构和制造技术，介绍了40余种典型集成电路制造技术，并描绘出工艺制程中各个工序的平面结构和工艺剖面结构。

如此深入地展示电路芯片工艺剖面结构，有助于电路设计、芯片制造、良率提高、产品质量改进、电路失效分析等。

《MOS集成电路结构与制造技术》技术含量高，非常实用，可作为从事MOS集成电路设计、制造等方面工程技术人员的参考资料或者是公司员工培训的教材，也可以作为微电子专业高年级本科生的重要参考书，同时可供信息领域其他专业的学生和相关科研人员、工程技术人员参考。

集成电路各种剖面结构和工艺制程图示的复制引用，转载时，必须得到本版权所有者的同意，否则将依法追究责任。

<<MOS集成电路结构与制造技术>>

书籍目录

第1章 PMOS集成电路结构与制造技术1.1 铝栅E / E型PMOS结构1.2 硅栅E / E型PMOS结构1.3 铝栅E / D型PMOS结构1.4 硅栅E / D型PMOS结构1.5 铝栅E / E型PMOS工艺制程1.6 硅栅E / D型PMOS工艺制程

第2章 NMOS集成电路结构与制造技术2.1 E / E型NMOS (A) 结构2.2 E / E型NMOS (B) 结构2.3 E / D型NMOS (A) 结构2.4 E / D型NMOS (B) 结构2.5 E / D型NMOS (C) 结构2.6 E / D型NMOS EPROM结构2.7 E / D型NMOS EEPROM结构2.8 E / D型NMOS DRAM结构2.9 E / D型NMOS SRAM结构2.10 E / E型NMOS (A) 工艺制程2.11 E / D型NMOS (A) 工艺制程2.12 E / D型NMOS (B) 工艺制程2.13 E / D型NMOS SRAM工艺制程

第3章 P-Well CMOS集成电路结构与制造技术3.1 铝栅P-Well CMOS (A) [薄场]结构3.2 铝栅P-Well CMOS (B) [薄场]结构3.3 铝栅P-Well CMOS (A) [厚场]结构3.4 铝栅P-Well CMOS (B) [厚场]结构3.5 铝栅P-Well CMOS (C) [厚场]结构3.6 铝栅P-Well CMOS (D) [厚场]结构3.7 铝栅P-Well CMOS (E) [厚场]结构3.8 硅栅P-Well CMOS (A) 结构3.9 硅栅P-Well CMOS (B) 结构3.10 硅栅P-Well CMOS (C) 结构3.11 硅栅P-Well CMOS (D) 结构3.12 硅栅P-Well CMOS (E) 结构3.13 硅栅P-Well CMOS (F) 结构3.14 铝栅P-Well CMOS (A) [薄场]工艺制程3.15 铝栅P-Well CMOS (A) [厚场]工艺制程3.16 铝栅P-Well CMOS (C) [厚场]工艺制程3.17 硅栅P-Well CMOS (B) 工艺制程3.18 硅栅P-Well CMOS (C) 工艺制程3.19 硅栅P-Well CMOS (E) 工艺制程

第4章 N-Well CMOS集成电路结构与制造技术4.1 N-Well CMOS (A) 结构4.2 N-Well CMOS (B) 结构4.3 N-Well CMOS (C) 结构4.4 N-Well CMOS (D) 结构4.5 N-Well CMOS EPROM结构4.6 N-Well CMOS EEPROM (A) 结构4.7 N-Well CMOS EEPROM (B) 结构4.8 N-Well CMOS Flash (A) 结构4.9 N-Well CMOS Flash (B) 结构4.10 N-Well CMOS SRAM : 结构4.11 N-Well CMOS DRAM (A) / (B) 结构4.12 N-Well CMOS DRAM (C) / (D) 结构4.13 N-Well CMOS (C) 工艺制程4.14 N-Well CMOS (D) 工艺制程4.15 N-Well CMOS EPROM工艺制程4.16 N-Well CMOS EEPROM (A) 工艺制程4.17 N-Well CMOS DRAM (B) 工艺制程4.18 N-Well CMOS SRAM工艺制程

第5章 亚微米 / 深亚微米CMOS集成电路结构与制造技术5.1 亚微米Twin-Well CMOS (SMA) 结构5.2 亚微米Twin-Well CMOS (SMB) 结构5.3 亚微米Twin-Well CMOS (SMC) 结构5.4 亚微米Twin-Well CMOS (SMD) 结构5.5 亚微米CMOS Mask ROM (SMA) 结构5.6 亚微米CMOS Mask ROM (SMB) 结构5.7 亚微米CMOS Mask ROM (SMC) 结构5.8 亚微米CMOS EEPROM结构5.9 深亚微米Twin-Well CMOS (DSMA) 结构5.10 深亚微米Twin-Well CMOS (DSMB) 结构5.11 深亚微米Twin-Well CMOS (DSMC) 结构5.12 深亚微米Twin-Well CMOS (DSMD) 结构5.13 深亚微米Twin-Well CMOS (DSME) 结构5.14 超深亚微米Twin-Well CMOS (VDSM) 结构5.15 亚微米CMOS (SMB) 工艺制程5.16 亚微米CMOS (SMC) 工艺制程5.17 亚微米CMOS MASKROM (SMA) 工艺制程5.18 深亚微米CMOS (DSMB) 工艺制程5.19 深亚微米CMOS (DSMC) 工艺制程

第6章 低压 / 高压兼容CMOS集成电路结构与制造技术6.1 低压 / 高压兼容P-Well CMOS (A) 结构6.2 低压 / 高压兼容P-Well CMOS (B) 结构6.3 低压 / 高压兼容P-Well CMOS (C) 结构6.4 低压 / 高压兼容N-Well CMOS (A) 结构6.5 低压 / 高压兼容N-Well CMOS (B) 结构6.6 低压 / 高压兼容N-Well CMOS (C) 结构 : 6.7 低压 / 高压兼容Twin-Well CMOS (A) 结构6.8 低压 / 高压兼容Twin-Well CMOS (B) 结构6.9 低压 / 高压兼容Twin-Well CMOS (C) 结构6.10 LV / HV兼容P-Well CMOS (B) 工艺制程6.11 LV / HV兼容P-Well CMOS (B*) 工艺制程6.12 LV / HV兼容N-Well CMOS (B) 工艺制程6.13 LV / HV兼容N-Well CMOS (C) 工艺制程6.14 LV / HV兼容Twin-Well CMOS (B) 工艺制程

第7章 BiCMOS集成电路结构与制造技术7.1 P-Well BiCMOS[c]- (A) 结构7.2 P-Well BiCMOS[C]- (B) 结构7.3 P-Well BiCMOS[B]- (A) 结构7.4 P-Well BiCMOS[B]- (B) 结构7.5 P-Well BiCMOS[B]- (C) 结构7.6 P-Well BiCMOS[B]- (D) 结构7.7 N-Well BiCMOS[C]- (A) 结构7.8 N-Well BiCMOS[C]- (B) 结构7.9 N-Well BiCMOS[B]- (A) 结构7.10 N-Well BiCMOS[B]- (B) 结构7.11 Twin-Well BiCMOS[C]结构7.12 Twin-Well BiCMOS[B]- (A) 结构7.13 Twin-Well BiCMOS[B]- (B) 结构7.14 Twin-Well BiCMOS[B]- (C) 结构7.15 Twin-Well BiCMOS[B]- (D) 结构7.16 Twin-Well BiCMOS[B]- (E) 结构7.17 P-Well BiCMOS[C]- (A) 工艺制程7.18 P-Well BiCMOS[B]- (D) 工艺制程7.19 N-Well BiCMOS[C]- (A) 工艺制程7.20 N-Well BiCMOS[B]- (A) 工艺制程7.21 Twin-Well BiCMOS[B]- (A) 工艺制程7.22 Twin-Well BiCMOS[B]- (D) 工艺制程

第8章 LV / HV兼容BiCMOS集成

<<MOS集成电路结构与制造技术>>

电路结构与制造技术8.1 低压 / 高压兼容P-Well BiCMOS[C]- (A) 结构8.2 低压 / 高压兼容P-Well BiCMOS[C]- (B) 结构8.3 低压 / 高压兼容P-Well BiCMOS[B]- (A) 结构8.4 低压 / 高压兼容P-Well BiCMOS[B]- (B) 结构8.5 低压 / 高压兼容N-Well BiCMOS[C]- (A) 结构8.6 低压 / 高压兼容N-Well BiCMOS[C]- (B) 结构8.7 低压 / 高压兼容N-Well BiCMOS[B]- (A) 结构8.8 低压 / 高压兼容N-Well BiCMOS[B]- (B) 结构8.9 低压 / 高压兼容Twin-Well BiCMOS[C]- (A) 结构8.10 低压 / 高压兼容Twin-Well BiCMOS[C]- (B) 结构8.11 低压 / 高压兼容Twin-Well BiCMOS[B]- (A) 结构8.12 低压 / 高压兼容Twin-Well BiCMOS[B]- (B) 结构8.13 低压 / 高压兼容Twin-Well BiCMOS[B]- (C) 结构8.14 LV / HVP-Well BiCMOS[C]- (A) 工艺制程8.15 LV / HVP-Well BiCMOS[B]- (A) 工艺制程8.16 LV / HVN-Well BiCMOS[C]- (B) 工艺制程8.17 LV / HVN-Well BiCMOS[B]- (B) 工艺制程8.18 LV / HVTwin-Well BiCMOS[SI]- (A) 工艺制程8.19 LV / HVTwin-Well BiCMOS[B]- (B) 工艺制程第9章 LV / HV兼容BCD集成电路结构与制造技术9.1 低压 / 高压兼容P-Well BCD[C]- (A) 结构9.2 低压 / 高压兼容P-Well BCD[c]- (B) 结构9.3 低压 / 高压兼容P-Well BCD[C]- (C) 结构9.4 低压 / 高压兼容P-Well BCD[C]- (D) 结构9.5 低压 / 高压兼容N-Well BCD[C]- (A) 结构9.6 低压 / 高压兼容N-Well BCD[C]- (B) 结构9.7 低压 / 高压兼容N-Well BCD[c]- (c) 结构9.8 低压 / 高压兼容N-Well BCD[c]- (D) 结构9.9 低压 / 高压兼容N-Well BCD[C]- (E) 结构9.10 低压 / 高压兼容N-Well BCD[C]- (F) 结构9.11 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (A) 结构9.12 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (B) 结构9.13 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (C) 结构9.14 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (D) 结构9.15 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (E) 结构9.16 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (F) 结构9.17 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (A1) 结构9.18 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (A2) 结构9.19 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (A3) 结构9.20 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (A4) 结构9.21 低压 / 高压兼容P-Well BCD[B]- (B*) 结构9.22 低压 / 高压兼容Twin-Well BCD[C]结构9.23 低压 / 高压兼容Twin-Well BCD[B]结构9.24 LV / HVP-Well BCD[C]- (C) 工艺制程9.25 LV / HV-N-Well BCD[C]- (D) 工艺制程9.26 LV / HVP-Well BCD[B]- (F) 工艺制程9.27 LV / HVP-Well BCD[B]- (A3) 工艺制程9.28 LV / HVP-Well BCD[B]- (B*) 工艺制程9.29 LV / HVTwin-Well BCD[B]工艺制程附录 参考资料附录 术语缩写对照附录 简要提示

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>